(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-328908

(43)公開日 平成4年(1992)11月17日

(51) Int.Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H03H 3/08

7259 - 5 J

庁内整理番号

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号

特顏平3-98584

(22)出願日

平成3年(1991)4月30日

(71)出願人 000006105

株式会社明電舎

東京都品川区大崎2丁目1番17号

(72) 発明者 幸地 彰

東京都品川区大崎2丁目1番17号 株式会

社明電舎内

(74)代理人 弁理士 志賀 富士弥 (外1名)

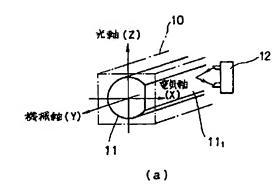
(54) 【発明の名称】 弾性表面波用水晶基板の製造方法

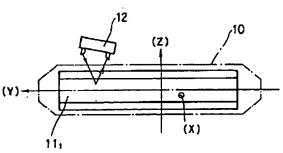
(57)【要約】

【目的】 弾性表面波用水晶基板の加工を安定的に高精度で行う。

【構成】 水晶原石10の電気軸(X)および光軸

- (Z) を測定基準軸に定めるとともに、各軸(X)
- (2) に対する面の角度を秒単位で測定するカット面検 出装置12を備え、測定基準軸に対する面角度を確認し ながら水晶原石10の切断および研磨を行って電気軸
- (X) と直交且つ光軸(Z) と平行の面11 を有する基板プロック11 を成形した後、眩基準プロック11 を 光軸(Z) に対して所定角度 θ をもつ偏光軸(Z') と 平行に設定厚に切断してウェハ状の弾性表面波用水晶基板を成形するようにしたものである。





1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 各々直交する電気軸(X)と光軸(Z) とを含む結晶軸を有する水晶の切断を行い、ウェハ状の 水晶基板に成形する弾性表面波用水晶基板の製造方法に おいて、電気軸(X)および光軸(Z)を測定基準軸に 定めるとともに、各軸(X)(Z)に対する面の角度を 測定する面角度測定手段を備え、該面角度測定手段で加 工角度を確認しながら前記水晶を切断して研磨を行い、 電気軸(X)と直交し且つ光軸(Z)と平行の面を有す る基板プロックを成形する基板プロック成形工程と、該 10 基準プロックを光軸 (Z) に対して所定角度θをもつ偏 光軸(Z')と平行に設定厚に切断してウェハ状の水晶 基板とする基板成形工程とを有することを特徴とする弾 性表面波用水晶基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、弾性表面波基板として 用いられる水晶基板の製造方法に関し、特に、水晶の結 晶軸を測定基準軸に定めて該基準軸からの面角度を確認 しながら水晶基板を製造する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】弾性表面波(以下SAWとする)は弾性 体の表面付近にエネルギーが集中して伝搬する波であ り、このSAWの性質を利用した電子デバイスが実用化 されている。また、最近は、水晶チップの表面にSAW 電極を設けた高周波用のSAW振動子片も開発され、電 子デバイスに組み込まれるようになってきた。

【0003】図3はこのようなSAW振動子片を大量生 産するための水晶基板の外形図であり、偏光軸(2') と平行且つ電気軸(X)と直交方向に形成された電気軸 30 面(オリエンテーションフラット面)11と、平坦なS AW伝搬面12とを有する所定厚みt2の水晶基板1に、 SAWの伝搬方向が電気軸(X)と平行になるように、 複数のSAW電極パターン2を、例えばIC製造の際に 行われるフォトレジスト法により蒸着したものである。

【0004】各SAW電極パターン2は電気軸面1:を 位置基準面として同時に水晶基板1のSAW伝搬面12 に蒸着され、この水晶基板1を切断してSAW振動子片 を得るときも、同様に電気軸面11を位置基準面として いる。

【0005】そのため、SAW伝搬面12の平坦度はも ちろん、電気軸面 11の加工にはかなりの高精度が要求 される。一般に電気軸面 11の加工誤差αは、電気軸 (X) との直交面に対して±0.5°以内とされてお り、これを超える場合にはSAWの伝搬方向が電気軸 (X) の方向からずれすぎて所望のSAW特性が得られ ず、ひいてはこのようなSAW振動子片を組み込んだ電 子デバイスが設計どおりに作動しない事態を生ずる。

【0006】ところで、水晶基板1の現在の製造方法と しては、厚みすべり水晶振動子すなわち両側面に配置さ 50 め、水晶の電気軸(X)および光軸(2)を測定基準軸

れた電極から電圧が印加されることにより発振する水晶 振動子とほぼ同様の製造方法が用いられている。

【0007】すなわち、図4に示すように、水晶原石 (人工水晶を含む。以下同じ) 20を光軸(2)とある 角度θを持つ偏光軸(Z')方向に厚みt1で切断して 素板を得、この素板を厚み t2 に表面研磨した後に図5 (a) のように貼付をして素板プロック30を形成し、 これを機械等により図5 (b) のような形状の基板プロ ック31に外形加工している。その際、角度を秒単位で 測定することができるカット面検査装置のような面角度 測定手段を用い、電気軸(X)および偏光軸(Z')に 対する角度を測定(確認)しながら、切断および成形加 工を行っている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記製 造方法では水晶基板の外形加工を高精度で安定に行うこ とが極めて困難であった。

【0009】すなわち、外形加工についても加工面を前 記カット面検査装置によって測定しながら加工できれば 20 良いのであるが、現在の方法では図5(a),(b)に 示すように、素板を貼付してプロック30に形成した後 に外形加工を行うので、加工方向の測定面が切断厚み幅 方向となる。カット面検査装置は、X線をプロック30 の被検査面に照射してその際のX線回折結果に基づいて 電気軸(X)の方向を測定するものであるが、素板の一 片々の厚み t2が極めて薄いので、正確な測定が不可能 であった。そのため、図3に示した電気軸面11の加工 精度αを±0.5°以内になるように角度の測定を行い ながら電気軸面 11 の正確な外形加工を行うことが極め て困難であった。

【0010】また、一旦切断され、所定厚みt2に表面 研磨された素板を、接着剤等で再び貼付してプロック3 0を形成した後に外形加工をするため、貼付のときにず れによる誤差を生じ易く、貼付した全ての素板について 加工精度αを安定的に高めることが困難であった。

【0011】したがって、現在のこのような製造方法で は、外形加工の途中における加工精度αの確認が高精度 に行えないため、製品たるSAW振動子片の品質と歩留 まり低下をもたらす要因となり、強く改善が求められて 40 いた。

【0012】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたも のであり、その目的とするところは、外形加工の途中に おける加工精度の確認が容易に行え、水晶基板1に仕上 げた時点での電気軸面の加工誤差αを安定的に±0.5 。以内に抑えることができるSAW用水晶基板の製造方 法を提供することにある。

[0013]

【課題を解決するための手段および作用】本発明に係る SAW用水晶基板の製造方法は、上記目的を達成するた 10

3

に定めるとともに、各軸(X)(Z)に対する面の角度を測定する面角度測定手段を備え、該面角度測定手段で加工角度を確認しながら水晶の切断および研磨を行って電気軸(X)と直交且つ光軸(Z)と平行の面を有する基板プロックを成形した後、該基準プロックを光軸(Z)に対して所定角度 θ をもつ偏光軸(Z')と平行に設定厚に切断してウェハ状の水晶基板を成形する。

[0014]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細 に説明する。

【0015】本実施例の製造方法は、従来の厚みすべり水晶振動子の外形寸法が5~12 φと小さいものであるのに対し、SAW用水晶基板のそれは通常76 φ(3インチ)以上であり、水晶原石の段階で外形加工できるという点に着目したもので、水晶原石を直接基板プロックに加工するプロック成形工程と該基板プロックを水晶基板に加工する基板成形工程とを有する。図1および図2を参照してこれら工程について具体的に説明する。

【0016】図1(a)は本実施例によるプロック成形工程を示す斜視図、同図(b)はその正面図である。図 20中、一点破線は水晶原石10の形状、結晶軸(X, Y, Z)以外の実線は加工後の基板プロック11の形状を表している。

【0017】本実施例では、電気軸(X)および光軸 (2) を測定基準軸に定め、最初に断面矩形状の水晶原 石10から断面略半月状の基板プロック11を図示を省 略した機械を用いて直接切り出す。この点従来の製造方 法と異なる。詳しく説明すると、水晶原石10を例えば 円柱状プロックに切断した後、その側部面であって電気 軸(X)に対する角度が90°(直角)且つ光軸(Z) に対する角度が0°(平行)の面を、従来のものと同一 のカット面検査装置12で測定しながら切断および研磨 する。これにより形成された面は、図3の水晶基板1に おける電気軸面(オリエンタルフラット面) 11 に対応 する面111となる。この場合、水晶原石10の機械軸 (Y) 方向は充分長く、電気軸面に対応する面1 1: も 広いので、電気軸(X)および光軸(Z)に対する面角 度の測定は容易であり、また、基板プロック11に成形 した後の精度確認も容易となる。したがって、電気軸面 に対応する面111の加工精度は充分高いものが得られ 40 る。なお、この電気軸面に対応する面111とその他の 面の加工手順を逆にすることもできる。

【0018】上記工程により基板プロック11の加工精度が設定精度で仕上がっていることを確認した後、本実施例では図2に示すような基板成形工程を行う。

【0019】すなわち、光軸 (Z) を測定基準軸とし、カット面検査装置12と図示を省略した切断工具を用いて光軸 (Z) とある角度 θ をもつ偏光軸 (Z') と平行に切断して設定厚み t_1 のウェハ状水晶素板13を得る。その際、基板プロック11の電気軸面に対応する面 50

1 1 1 は充分広いので、結晶軸(X, Y, Z, Z')の 測定が容易であり、充分に高い精度で加工および確認が 行える。

【0020】この水晶素板13の切断面は平坦に研磨加工され、図3に示したような電気軸面11を有する厚みt2の水晶基板1に仕上げられる。その後、この電気軸面11を位置基準面として複数のSAW電極パターン2が蒸着され、個々の電極パターン毎に切断されてSAW振動子片として製品化される。

【0021】このように、本実施例の製造方法によれば、水晶原石10から基板プロック11を形成する過程および完了の時点で各々水晶の電気軸(X)および光軸(2)に対する面角度を高精度に測定および確認することができ、更に基板プロック11から水晶素板を成形する際においても高精度の面角度測定ができるので、水晶基板1の電気軸(X)と直交する電気軸面11の加工誤差αを安定に±0.5°以内に抑えることができ、更に限りなくゼロに近付けることもできる。

[0022]

20 【発明の効果】以上詳述したように、本発明では、SAW用水晶基板で特に高精度の加工が要求される電気軸面(オリエンタルフラット面=位置基準面)に対応する面を、結晶軸からの面角度の測定(確認)が容易な水晶原石の段階で予め形成し、この時点における加工精度が充分であることを確認した後にウェハ状の水晶基板に仕上げるようにしたので、SAW用水晶基板として許容される加工誤差 αの範囲(≦0.5°)を安定的且つ大幅にクリアした高精度の製造方法を確立することができる。これにより、大量生産されるSAW振動子片の品質向上と歩留まりの大幅な低下を図ることができる。

【0024】なお、本発明の製造方法は、SAW用水晶 基板の製造の外、水晶の結晶軸を基準軸として所定の面 角度で水晶原石から切り出される他の種類の水晶薄板の 製造にも適用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の製造方法における基板プロック成形工程を説明するための図であり、(a)は斜視図、(b)は側面図である。

【図2】本実施例の製造方法における基板成形工程を説明するための図である。

【図3】本発明が適用される弾性表面波用水晶基板の説明図である。

【図4】従来の製造方法における案板の加工工程を説明

6 W伝搬面、2…SAW電極パターン、10,20…水晶

原石、11,31…基板プロック、12…カット面角度

検出装置(面角度測定手段)、13…水晶素板、30…

するための図である。

【図 5】従来の製造方法における素板プロックの加工工程を説明するための図であり、(a) は素板を貼付した状態図、(b) は加工後の状態図である。

5

【符号の説明】

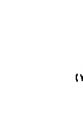
1 …弹性表面波用水晶基板、11 …電気軸面、12 …SA

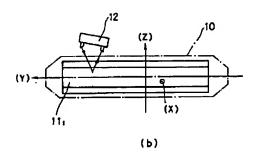
光轴(Z)

【図1】

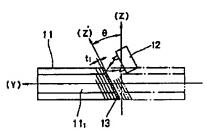
素板プロック、 t 1 ···(水晶)素板の厚み、 t 2 ···弾性表 面波用水晶基板の厚み。

【図2】

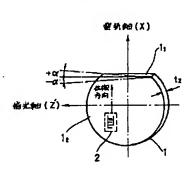


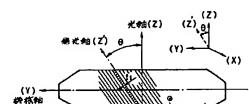


(a)



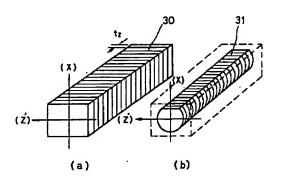
【図3】





[図4]

【図5】



PAT-NO:

JP404328908A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04328908 A

TITLE:

MANUFACTURE OF CRYSTAL SUBSTRATE FOR SURFACE

ACOUSTIC

WAVE

PUBN-DATE:

November 17, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KOUCHI, AKIRA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MEIDENSHA CORP

N/A

APPL-NO:

JP03098584

APPL-DATE: April 30, 1991

INT-CL (IPC): H03H003/08

US-CL-CURRENT: 333/193

ABSTRACT:

PURPOSE: To process a crystal substrate for a surface acoustic wave stably with high precision.

CONSTITUTION: An electric axis (X) and an optical axis (Z) of a quartz raw

ore 10 are decided as measurement reference axes and the method

cut-face detector 12 measuring an angle of a face with respect to the axes (X),

(Z) in the unit of seconds and the quartz raw ore 10 is cut and while

confirming a face angle with respect to the measurement reference axis to form

11 having a face 11<SB>1</SB> orthogonal to the a

electric axis

(X) and in parallel with the optical axis (Z). The reference block 11 is cut with a setting thickness in parallel with a polarized optical axis having a prescribed angle θ with respect to the optical axis (Z) to shape a wafer shaped quartz substrate for a surface acoustic wave.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio